



**Łukasiewicz**  
PORT  
Polski Ośrodek  
Rozwoju  
Technologii

I.dz. 630/2022/W

Wrocław dn. 10.03.2022 r.

## Odpowiedzi na pytania/ Answers to questions

Concerns: public procurement procedure entitled „Supply of materials for epitaxy for Łukasiewicz – PORT, divided into 10 lots”, case no: PO.271.8.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę materiałów do epitaksji dla Łukasiewicz – PORT, z podziałem na 10 części”, sprawa nr: PO.271.8.2022

The Contracting Authority informs that questions have been submitted to the tender. Therefore, in accordance with Art. 284 of the PPL (consolidated text Journal of Laws of 2021, item 1129 as amended) The Contracting Authority provides the content of the inquiries along with an explanation

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 284 ustawy PZP (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem.

### Question 1:

With regard to Lot 5, the description is unclear, in that it defines the "optical absorbance (Alpha) at 265 nm: 51-50 cm<sup>-1</sup>". In this case, the value range of '51-50' appears to be an error. Can you please clarify with the end user the desired alpha range? Further, I noted in the ToR preamble, item 2) that one project in the program is entitled "High-performance AlGaIn/GaN-HEMT transistors fabricated with hybrid MBE-MOVPE technology". If the lot 5 material, AlN substrates, is being utilized for this effort, it would be our recommendation that the product definition be changed to utilize high alpha, non-UV transparent substrates, which would not only be more appropriate for this application,

### Pytanie 1:

W odniesieniu do części 5 opis jest niejasny, ponieważ definiuje „absorbancję optyczną (alfa) przy 265 nm: 51-50 cm<sup>-1</sup>". W tym przypadku zakres wartości „51-50” wydaje się być błędny. Czy możesz określić z użytkownikiem końcowym pożądaną zakres alfa? Ponadto w preambule do ToR, punkt 2) zauważyłem, że jeden projekt w programie nosi tytuł „Wysokosprawne tranzystory AlGaIn/GaN-HEMT wykonane w technologii hybrydowej MBE-MOVPE”. Jeśli materiał z części 5, podłoża AlN, jest wykorzystywany do tego projektu, zalecamy zmianę produktu na podłoża o wyższym współczynniku alfa, nieprzezroczystych dla promieniowania UV, które byłyby nie tylko bardziej odpowiednie do tego



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Strona 1 z 2



**Łukasiewicz**

PORT  
Polski Ośrodek  
Rozwoju  
Technologii

but also less expensive. Of course, if the low alpha material is essential, then we can support that as well.

**Answer 1:**

Thank you for your attention. The correct value is alpha 31-50 cm<sup>-1</sup> at 265 nm at centerpoint.

Yes, we are sure that such low alpha index and double polished AlN wafers are necessary for our project focused on IIINAs materials. In case of advanced optical spectroscopy measurements such properties are required.

zastosowania, ale również tańsze. Oczywiście, jeśli materiał o niskiej wartości alfa jest niezbędny, służymy również wsparciem.

**Odpowiedź 1:**

Dziękuję za uwagę. Prawidłowa wartość to 31-50 cm<sup>-1</sup> alfa przy 265 nm w punkcie centralnym.

Tak, jesteśmy pewni, że obustronnie polerowane podłoża AlN o niskim współczynniku absorpcji są niezbędne do realizacji naszego projektu skupiającego się na materiałach IIINAs. W przypadku zaawansowanych pomiarów spektroskopii optycznej takie właściwości są wymagane.



NARODOWE CENTRUM NAUKI

**Strona 2 z 2**

